

## ДОСЛІДЖЕННЯ СЕНСОРІВ МАГНІТНОГО ПОЛЯ В ПРИСКОРЮВАЧІ ЕЛЕКТРОНІВ“ELIAS” В РЕЖИМІ ON-LINE

Большакова І.А., Загачевський Ю., Єрашок В.Е., Ковальова Н.В.,  
Мороз А.П., Макідо О.Ю., Шуригін Ф.М.

*Лабораторія Магнітних Сенсорів, кафедра напівпровідникової  
електроніки, Національний університет "Львівська політехніка"  
вул. Котляревського 1, м. Львів 79012, Україна.*

Дослідження параметрів напівпровідникових сенсорів магнітного поля під дією електронного опромінення є актуальною задачею в області космічного приладобудування. Крім того результати таких досліджень дають можливість оцінювати вплив радіаційних дефектів на параметри InSb без впливу ядерного легування, яке має місце при нейтронному опроміненні.

В роботі представлені результати дослідження впливу дози електронного опромінення на параметри тонкоплівкових сенсорів магнітного поля на основі InSb, одержаних методом рідиннофазної епітаксії. Під час виконання даної роботи була виготовлена та апробована апаратура для вимірювань параметрів досліджуваних зразків безпосередньо під час їх опромінення (метод on-line).

Проведений порівняльний аналіз результатів on-line досліджень із попередніми дослідженнями опромінення електронами подібних зразків тонкоплівкових сенсорів на основі InSb, що проводились за традиційною методикою вимірювання параметрів сенсорів до та після опромінення.

Проведені дослідження показали перспективність та ефективність використання методу on-line дослідження зміни параметрів напівпровідникових сенсорів під дією електронного опромінення.